

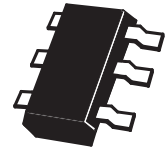
## SuperSOT™ 12V PNP SILICON LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR

### SUMMARY

$V_{CE0} = -12V$ ;  $R_{SAT} = 65m\Omega$ ;  $I_C = -3A$

### DESCRIPTION

This new 4th generation ultra low saturation transistor utilises the Zetex matrix structure combined with advanced assembly techniques to give extremely low on state losses. This makes it ideal for high efficiency, low voltage switching applications.



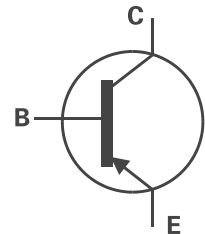
SOT23-6

### FEATURES

- Low Equivalent On Resistance
- Extremely Low Saturation Voltage
- $h_{FE}$  characterised up to 10A
- $I_C = 3A$  Continuous Collector Current
- SOT23-6 package

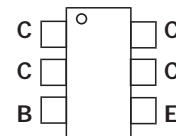
### APPLICATIONS

- DC - DC Converters
- Power Management Functions
- Power switches
- Motor control



### ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE (inches)	TAPE WIDTH (mm)	QUANTITY PER REEL
ZXT10P12DE6TA	7	8mm embossed	3000 units
ZXT10P12DE6TC	13	8mm embossed	10000 units



Top View

### DEVICE MARKING

717

# ZXT10P12DE6

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-12	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-12	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-10	A
Continuous Collector Current	$I_C$	-3	A
Base Current	$I_B$	-500	mA
Power Dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ (a) Linear Derating Factor	$P_D$	1.1 8.8	W mW/ $^\circ\text{C}$
Power Dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ (b) Linear Derating Factor	$P_D$	1.7 13.6	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_J:T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

## THERMAL RESISTANCE

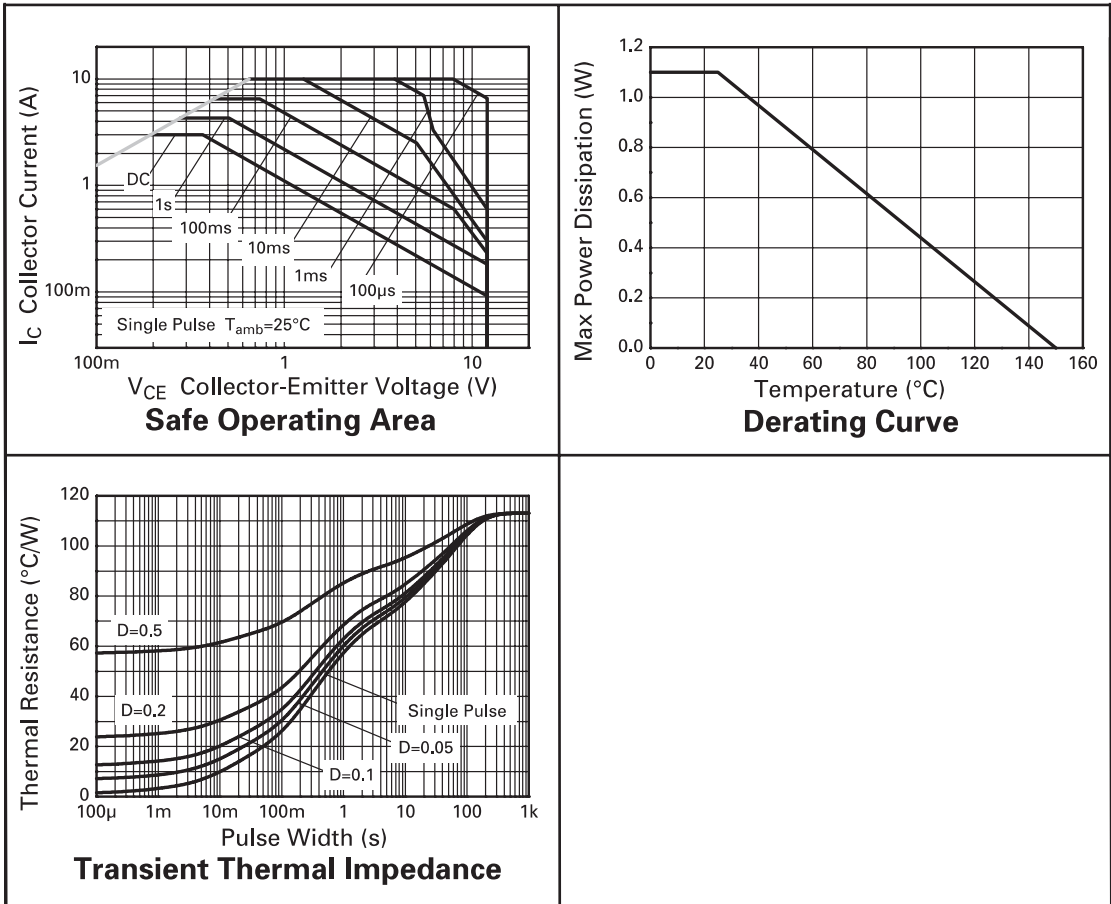
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to Ambient (a)	$R_{\theta JA}$	113	$^\circ\text{C/W}$
Junction to Ambient (b)	$R_{\theta JA}$	73	$^\circ\text{C/W}$

### NOTES

(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions

(b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at  $t \leq 5$  secs.

## TYPICAL CHARACTERISTICS



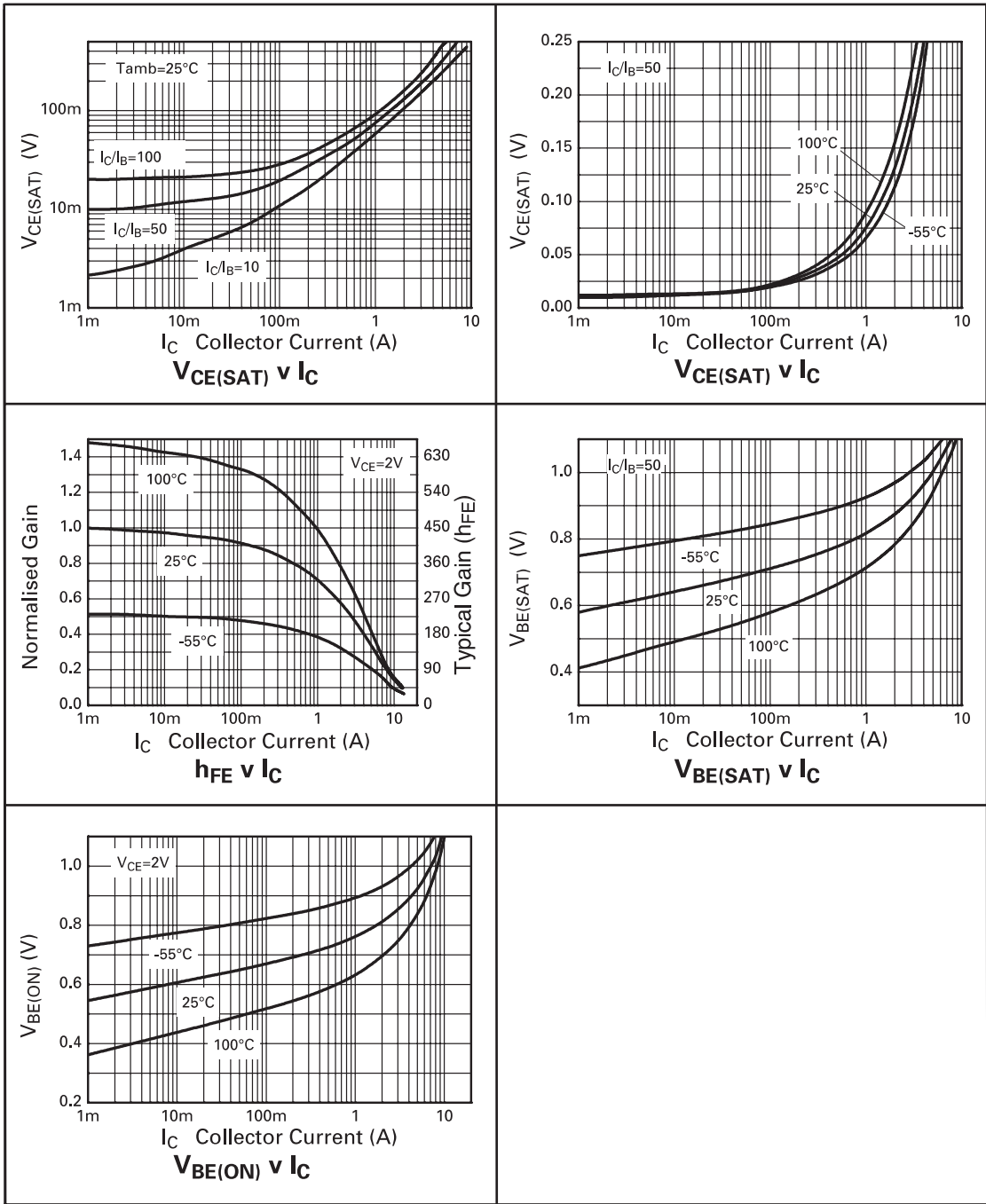
# ZXT10P12DE6

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-12	-35		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-12	-25		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	-8.5		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-100	nA	$V_{CB} = -10\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-100	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$			-100	nA	$V_{CES} = -10\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-10 -100 -100 -195	-17 -140 -150 -300	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1.5\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$ $I_C = -3\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.90	-0.95	V	$I_C = -3\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.85	-0.90	V	$I_C = -3\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	300 300 180 60 45	475 450 275 100 70			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -8\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$	80	110		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		21	30	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		70		ns	$V_{CC} = -6\text{V}, I_C = -2\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = -50\text{mA}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		130		ns	

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## TYPICAL CHARACTERISTICS



# ZXT10P12DE6

## PACKAGE DIMENSIONS



## PAD LAYOUT DETAILS



DIM	Millimetres		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.90	1.45	0.35	0.057
A1	0.00	0.15	0	0.006
A2	0.90	1.30	0.035	0.051
b	0.35	0.50	0.014	0.019
C	0.09	0.20	0.0035	0.008
D	2.80	3.00	0.110	0.118
E	2.60	3.00	0.102	0.118
E1	1.50	1.75	0.059	0.069
L	0.10	0.60	0.004	0.002
e	0.95 REF		0.037 REF	
e1	1.90 REF		0.074 REF	
L	0°	10°	0°	10°



Zetex plc.  
Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.  
Telephone: (44)161 622 4422 (Sales), (44)161 622 4444 (General Enquiries)  
Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH  
Streitfeldstraße 19  
D-81673 München  
Germany  
Telefon: (49) 89 45 49 49 0  
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.  
47 Mall Drive, Unit 4  
Commack NY 11725  
USA  
Telephone: (631) 543-7100  
Fax: (631) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.  
3701-04 Metroplaza, Tower 1  
Hing Fong Road,  
Kwai Fong, Hong Kong  
Telephone: (852) 26100 611  
Fax: (852) 24250 494

These are supported by  
agents and distributors in  
major countries world-wide  
© Zetex plc 2000

Internet: <http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



ISSUE 1 - SEPTEMBER 2000



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331